

XPS測定条件および結果

1. 試料

・ウエハ

2. XPS測定条件

・X線源: AIK α 線 加速電圧15kV

・ビーム径: 100 μ m ϕ

ビームの拡がりの影響により、周辺3倍程度の信号を拾う可能性がある

・スパッタ(深さ方向分析)条件: スパッタイオンAr⁺

※得られたデータに対して、当社保有のSiO₂標準サンプルのスパッタレートをを用い

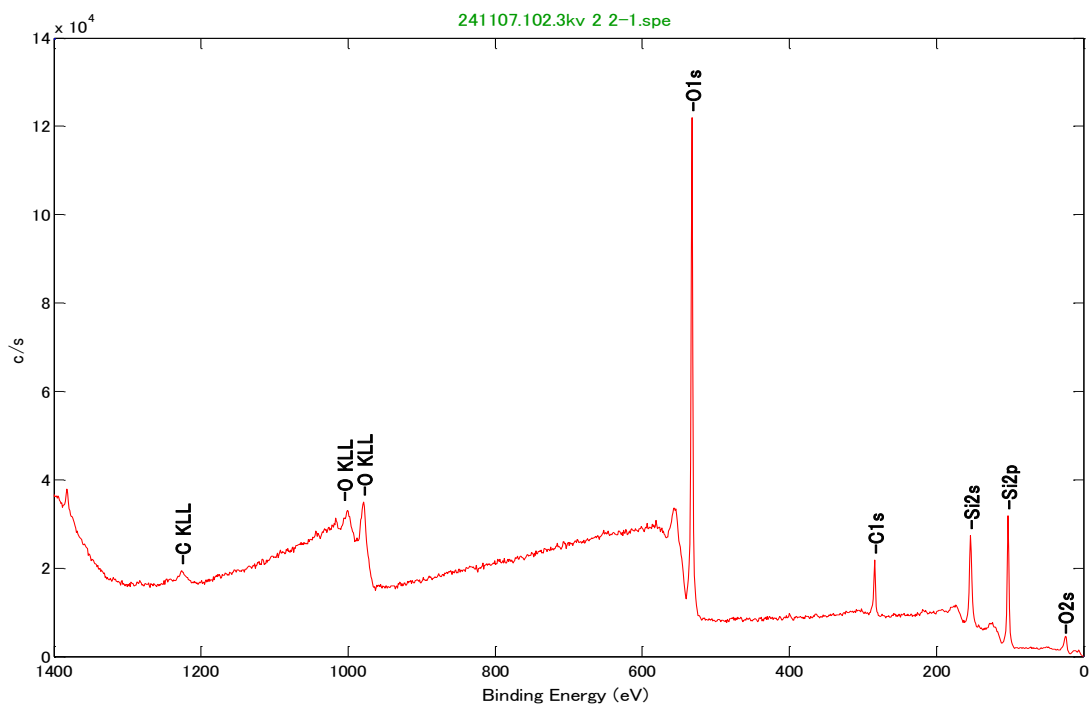
「スパッタ時間」→「スパッタ深さ」の換算を行った。

3. 結果(表面分析)

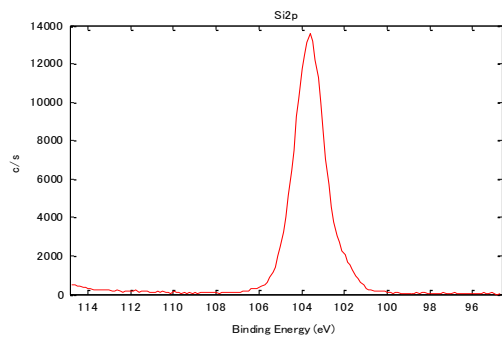
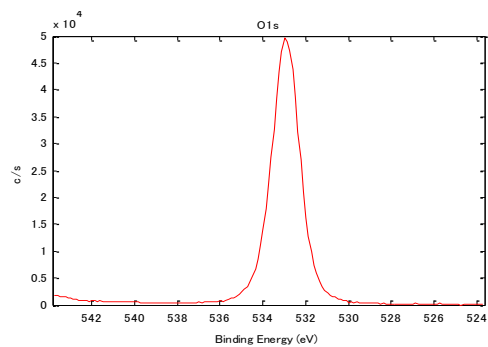
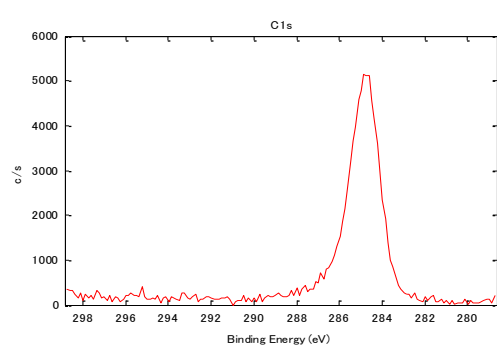
表面組成 Atomic%

	C	O	Si	計
ウエハ	16.3	57.1	26.6	100

XPS表面分析結果

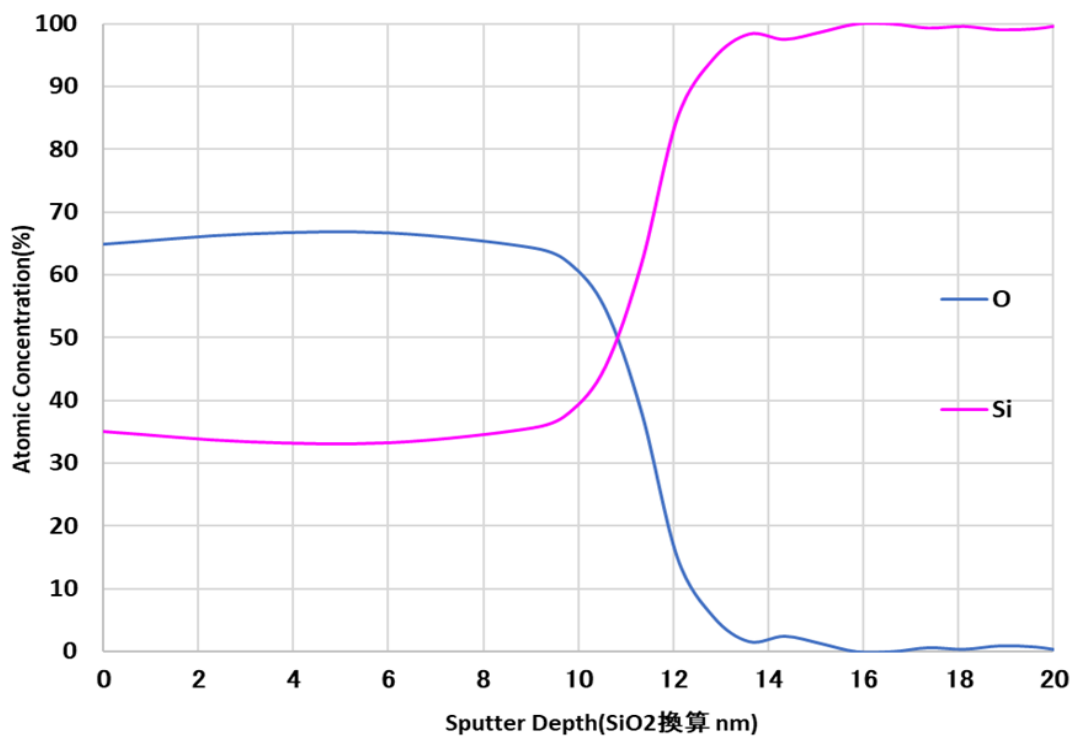


ワイドスキンスペクトル



ナロースキンスペクトル

XPS深さ方向分析結果



デプスプロファイル (O1s, Si2pで定量)